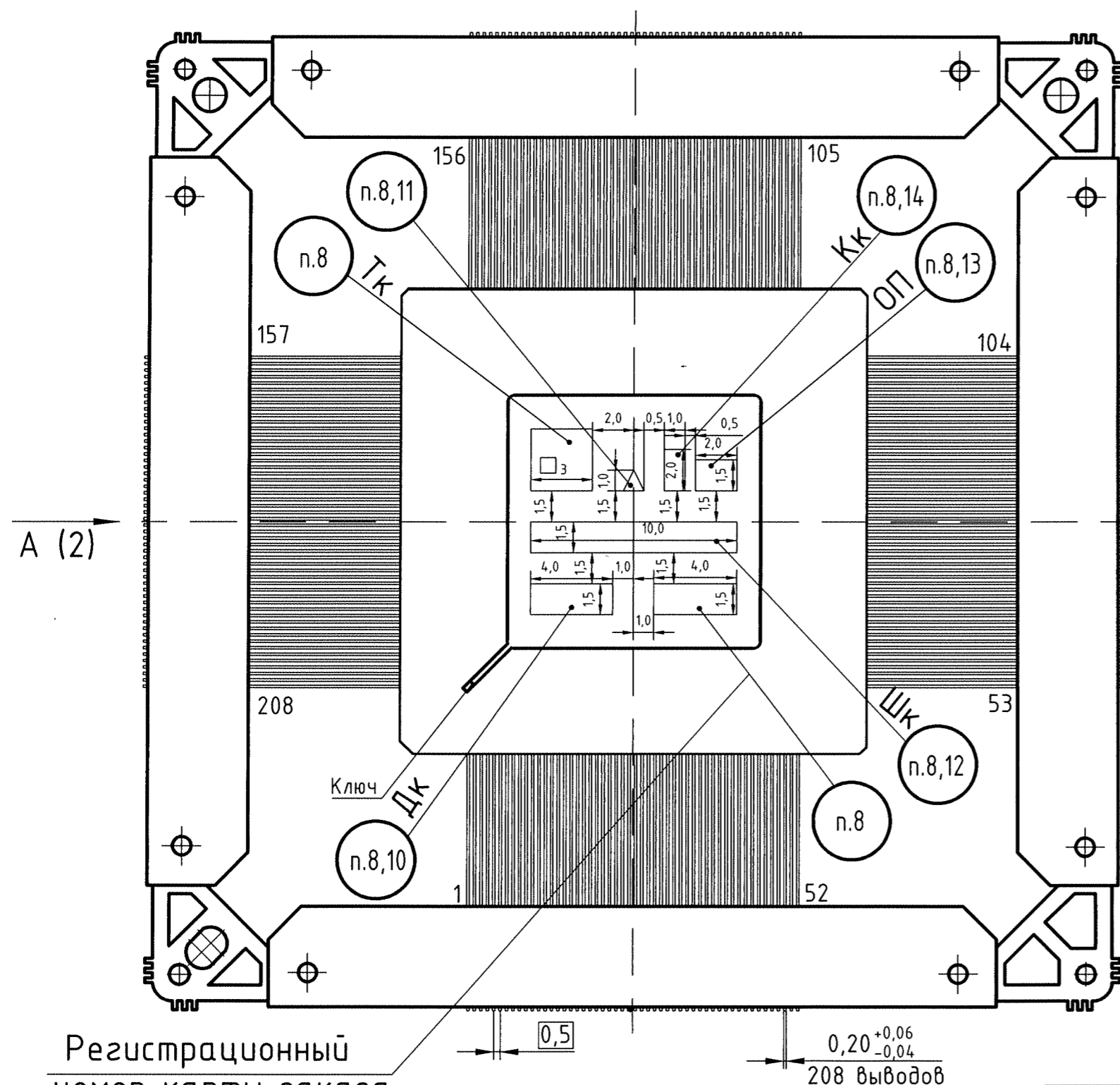


Г АВЛ.431268.018СБ

Рис.1 (Г АВЛ.431268.018)

(см. продолжение на листах 2, 3)



Регистрационный номер карты заказа

Таблица 1 - Модификация

Обозначение	Наименование изделия	Корпус	Маркировка Шк	Масса	Рис.
Г АВЛ.431268.018	5529ТР074	МК 4250.208-2	5529ТР074	max 16,0 г	1
-01	5529ТР074А	МК 4249.176-2	5529ТР074А	max 8,0 г	2

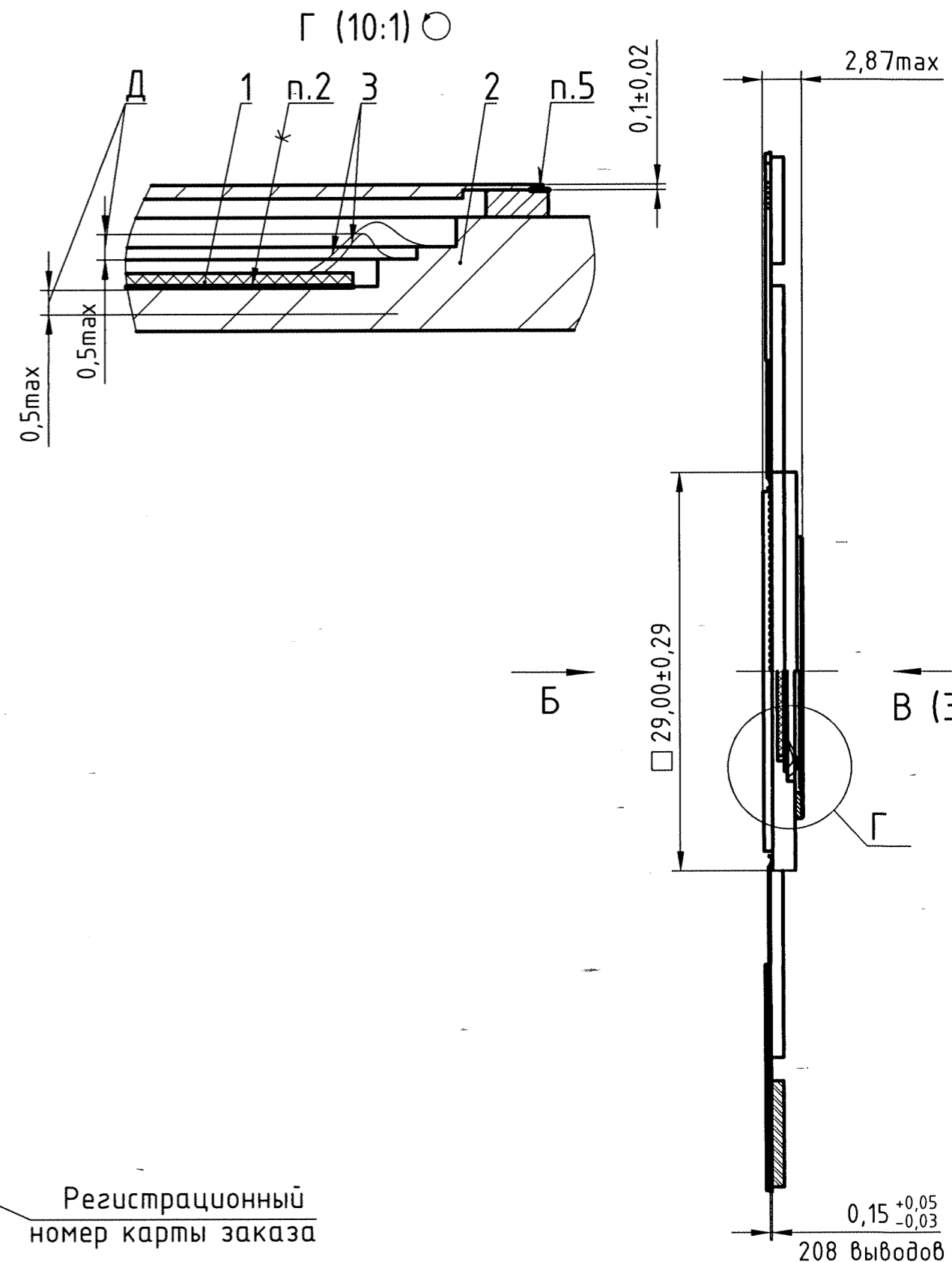
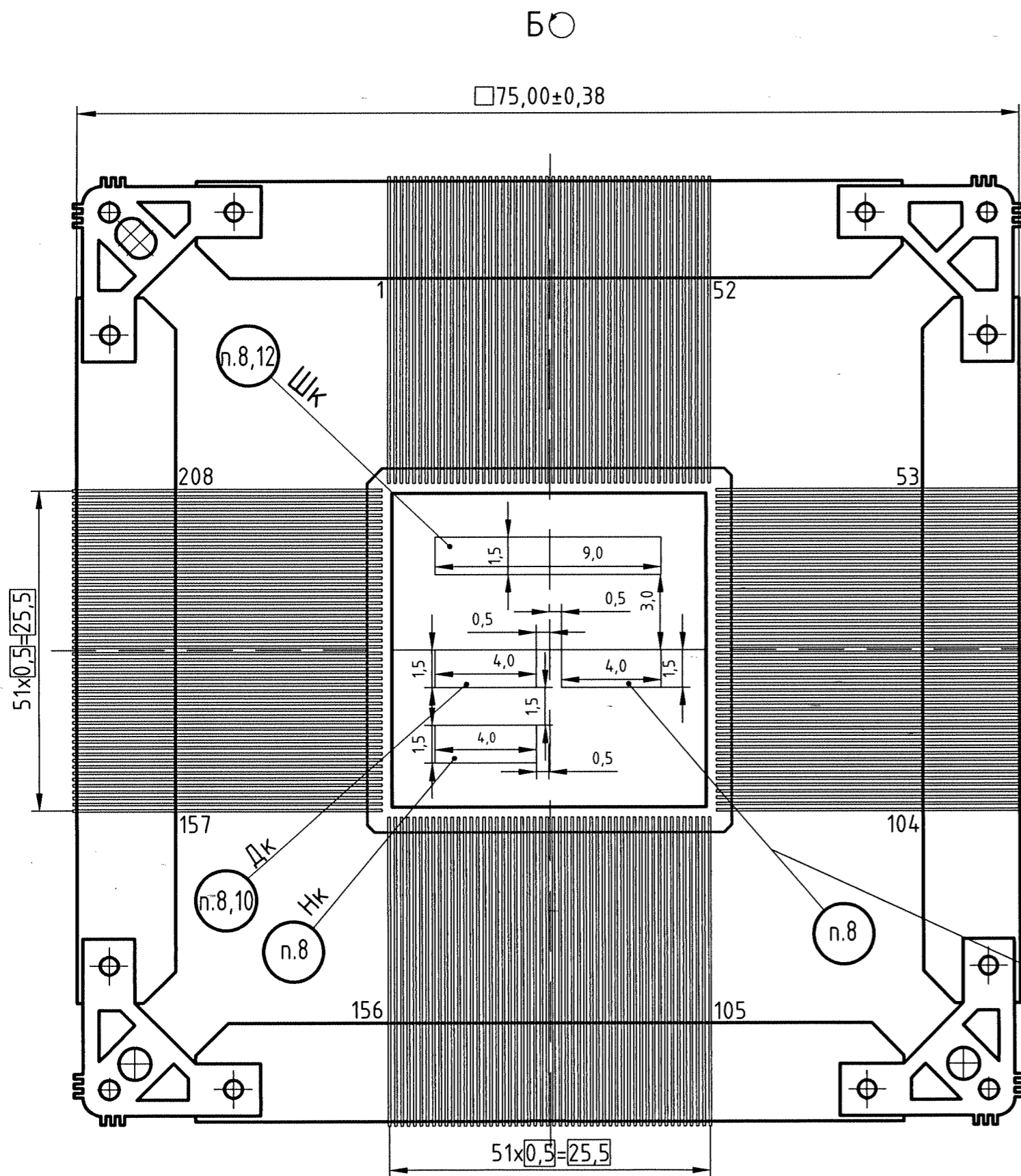
1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3 / \text{с}$.
7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида Г АВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, Оп, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно основному виду. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83.
- Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
9. С обратной стороны маркировать согласно виду Б для микросхемы 5529ТР074, виду Ж для 5529ТР074А.
10. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
11. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
12. В зоне Шк маркировать согласно таблице 1.
13. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом Оп.
14. Допускается нанесение клейма ВП и клейма Оп производить одновременно с маркировкой микросхемы.
15. Нумерация выводов приведена условно.
16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии 5529ТР074 соответствует данным этикетки Г АВЛ.431268.018ЭТ, 5529ТР074А - Г АВЛ.431268.018-01ЭТ.
17. Исполнения микросхем приведены в таблице 1.

Инв. № подл. 1579
 Подп. и дата
 Взам. инв. № Инв. № дубл.
 Подп. и дата
 Справ. №
 Перв. примен. Г АВЛ.431268.018

				Г АВЛ.431268.018СБ				
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>[Signature]</i>	13.12.19	Микросхемы интегральные 5529ТР074, 5529ТР074А Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		A	-	2,5:1
Разраб.	Астахова	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	13.11.19		Лист 1	Листов 6	
Пров.	Тукашкин	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	13.11.19				
512 ВП	Чириченко	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	13.12.19				
Н.контр.	Казаков	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	13.11.19				
Утв.	Денисов	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	13.11.19				

ГВЛ.431268.018СБ

Рис.1 (продолжение)
(ГВЛ.431268.018)



Регистрационный номер карты заказа

Инв. № подл. 1579	Подп. и дата С.С.О. 01.09.19	Взам. инв. № Инв. № дубл	Подп. и дата
----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	С.С.О.	01.09.19
Изм	Лист	Докум.	Подп.	Дата

ГВЛ.431268.018СБ

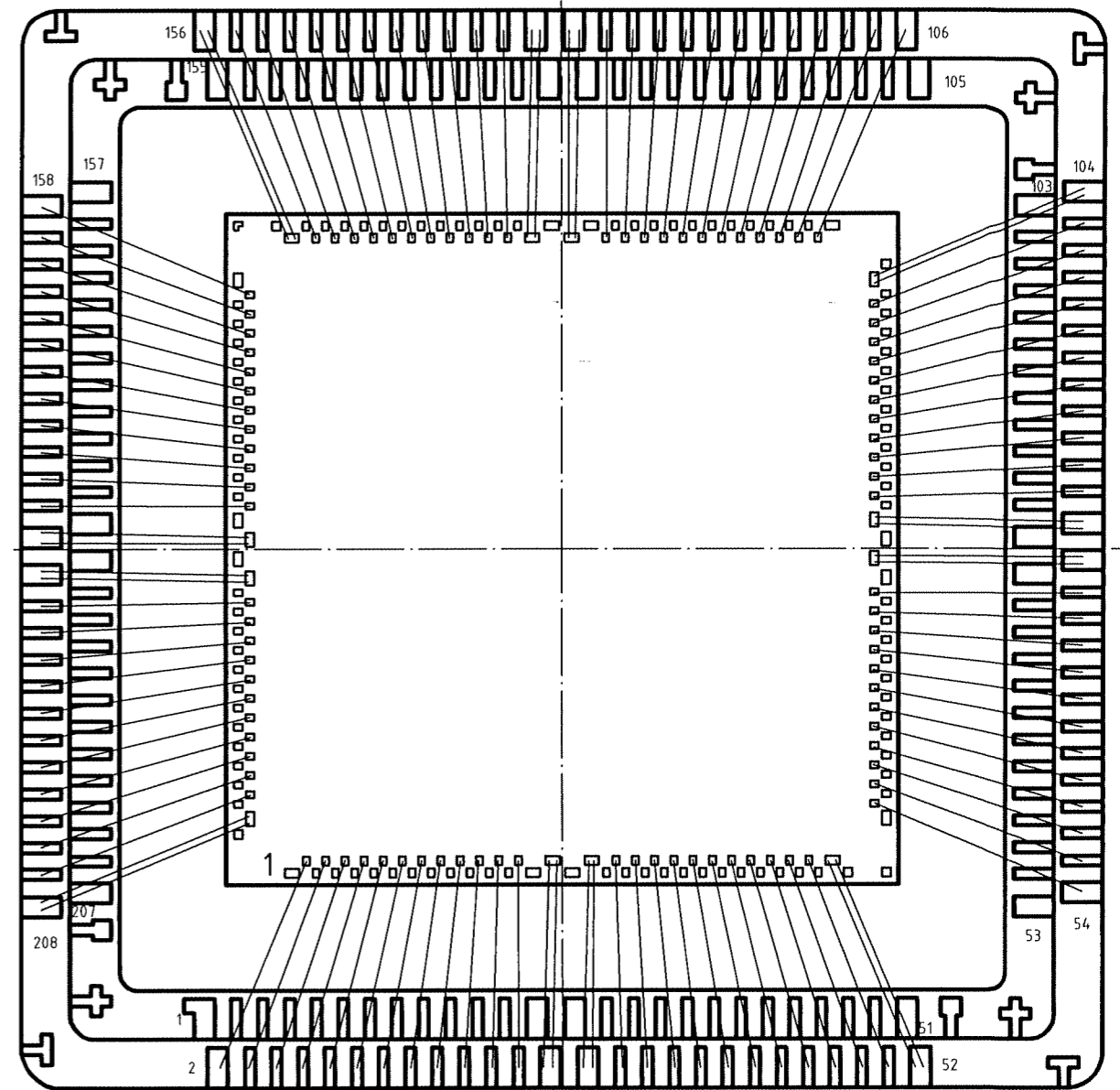
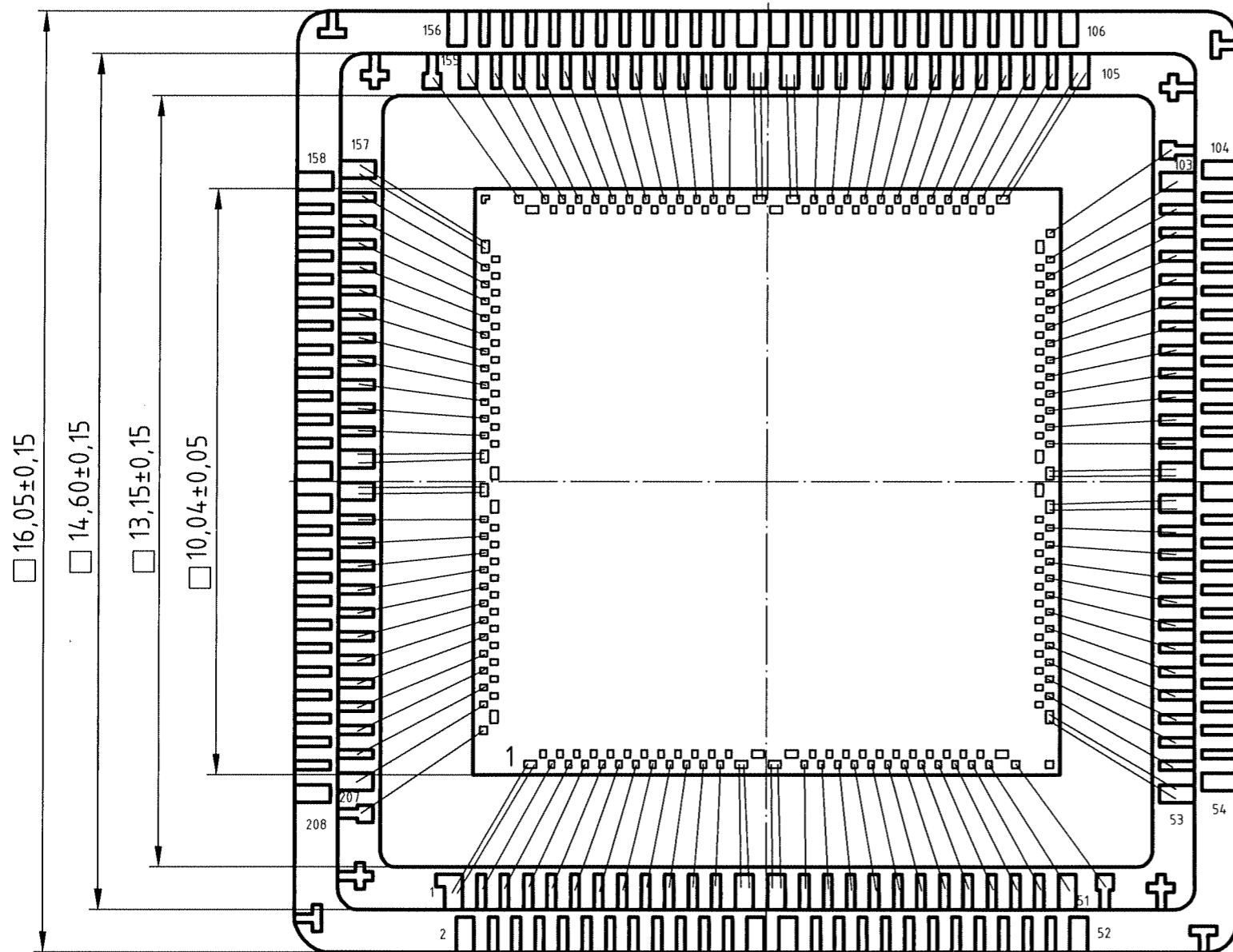
Лист
2

В (10:1) (2)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны
Разварка на внутренние площадки колодца

В (10:1) (2)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны
Разварка на внешние площадки колодца



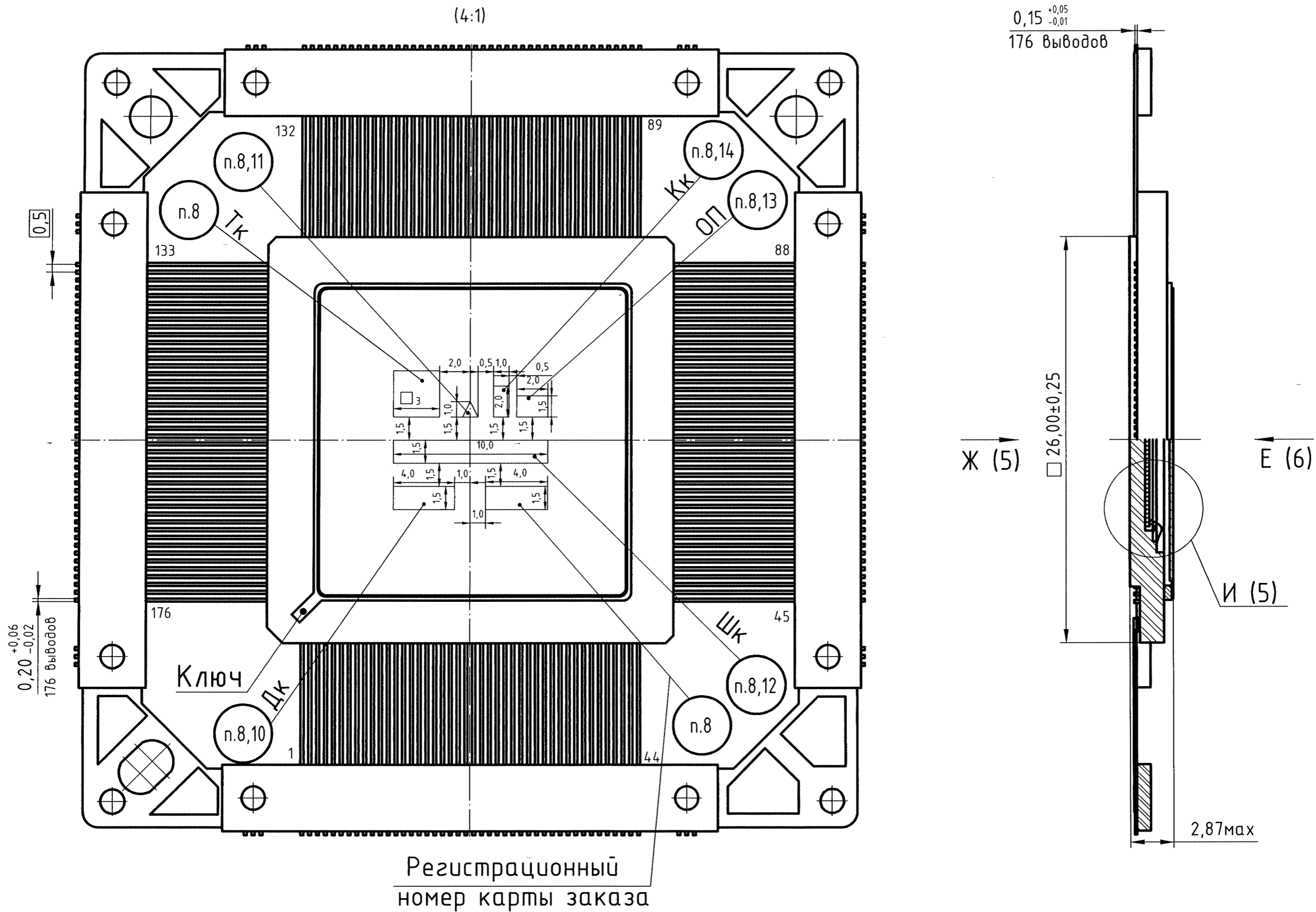
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
1599	<i>С.А. А. 01.20</i>			

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>С.А. А.</i>	05/21/19
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата

Г АВЛ.431268.018СБ

Рис.2 (Г АВЛ.431268.018-01)

(см. продолжение на листах 5, 6)



Инв. № подл.	1579	Подп. и дата	Prof Ad. M.A.
Взам. инв. №		Инв. № дубл	
Подп. и дата		Подп. и дата	

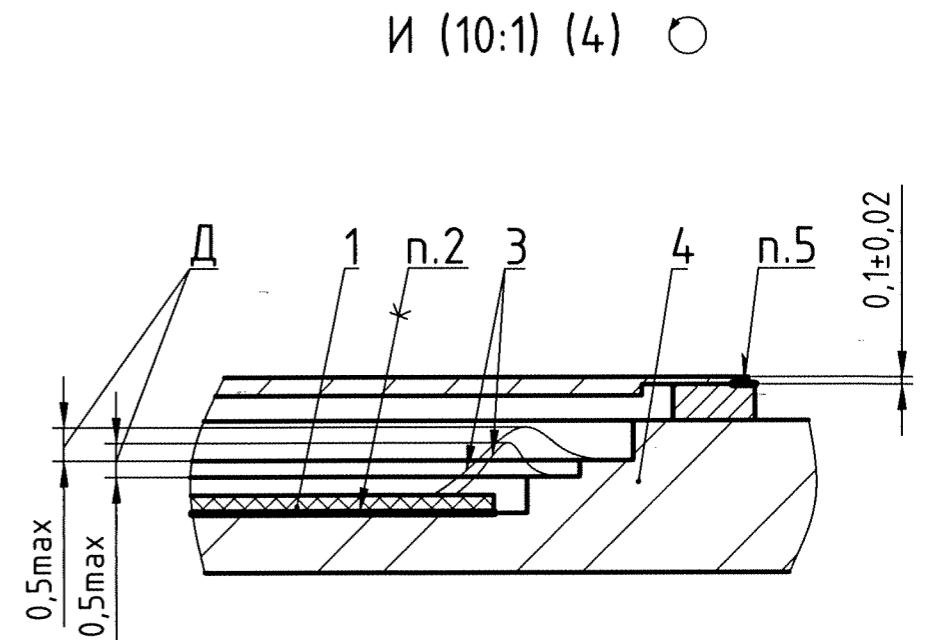
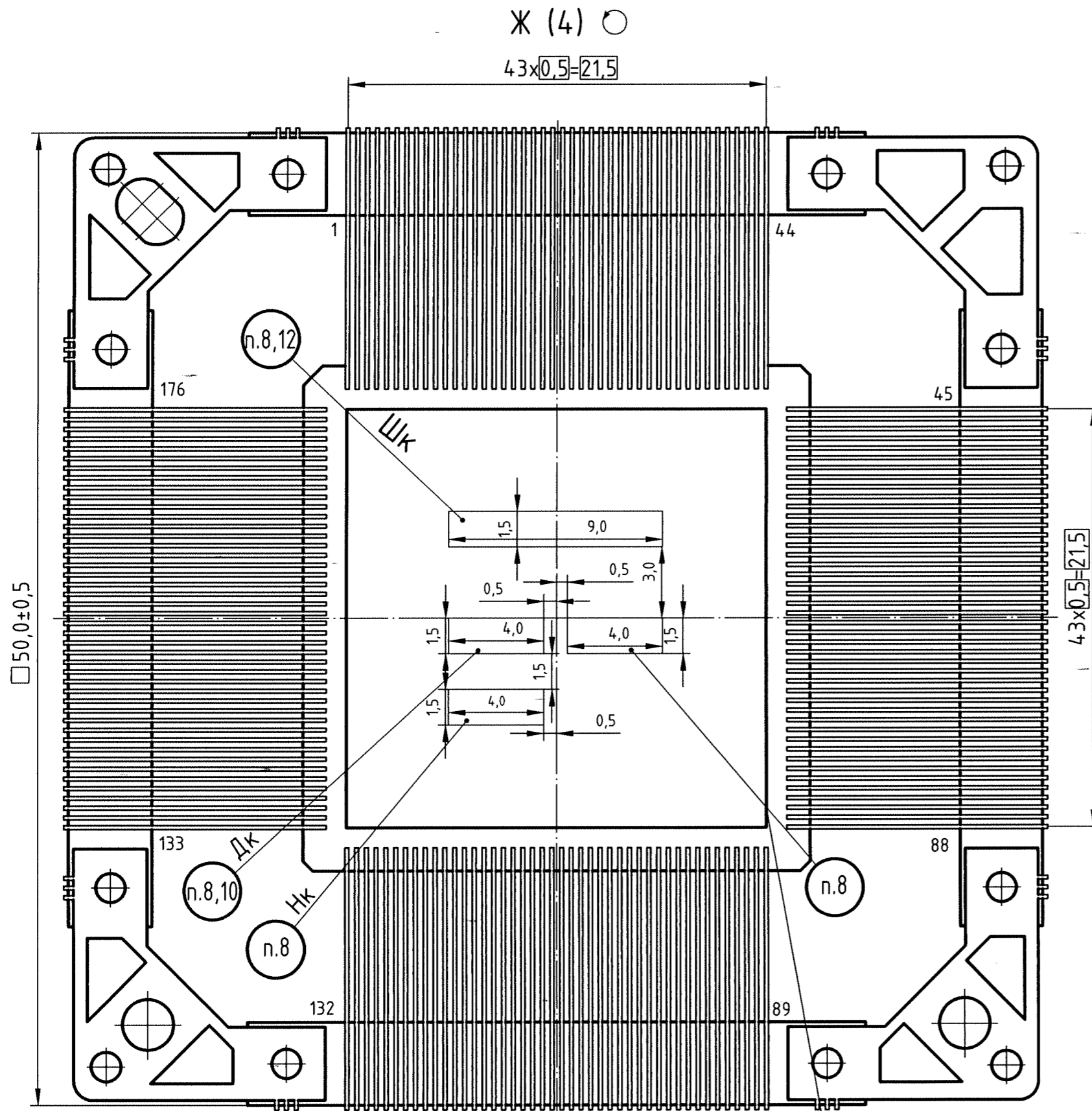
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>[Signature]</i>	09/2019
Изм/Лист	Докум.	Пбдп.	Дата	

Г АВЛ.431268.018СБ

Лист
4

Г АВЛ.431268.018СБ

Рис.2 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.018-01)



Инв. № подл. 15-39	Подп. и дата С.П. 22.09.20	Взам. инв. № Инв. № дубл	Подп. и дата
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	С.П.	22.09
Изм/Лист	Докум.	Подп.	Дата	

Г АВЛ.431268.018СБ

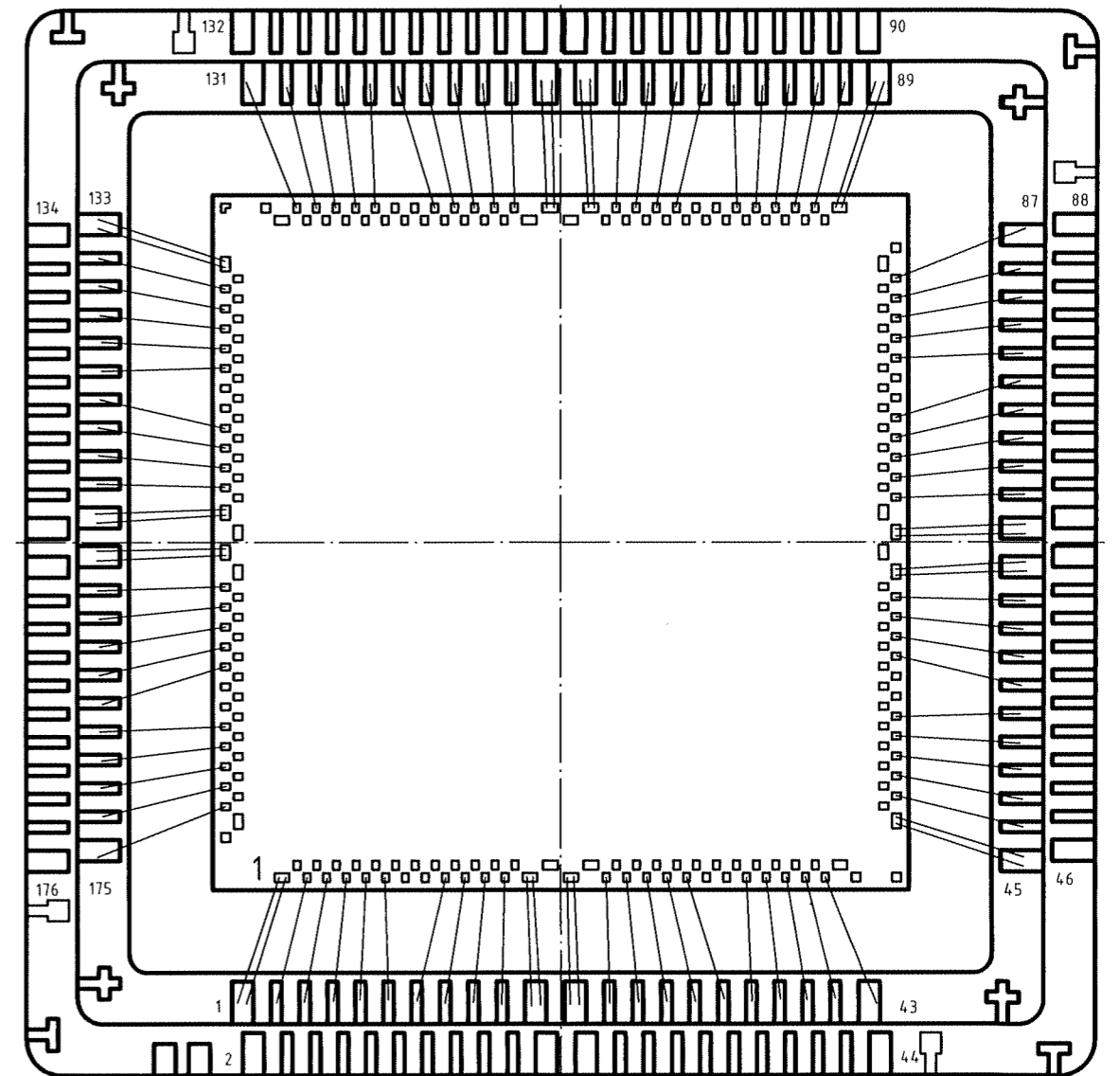
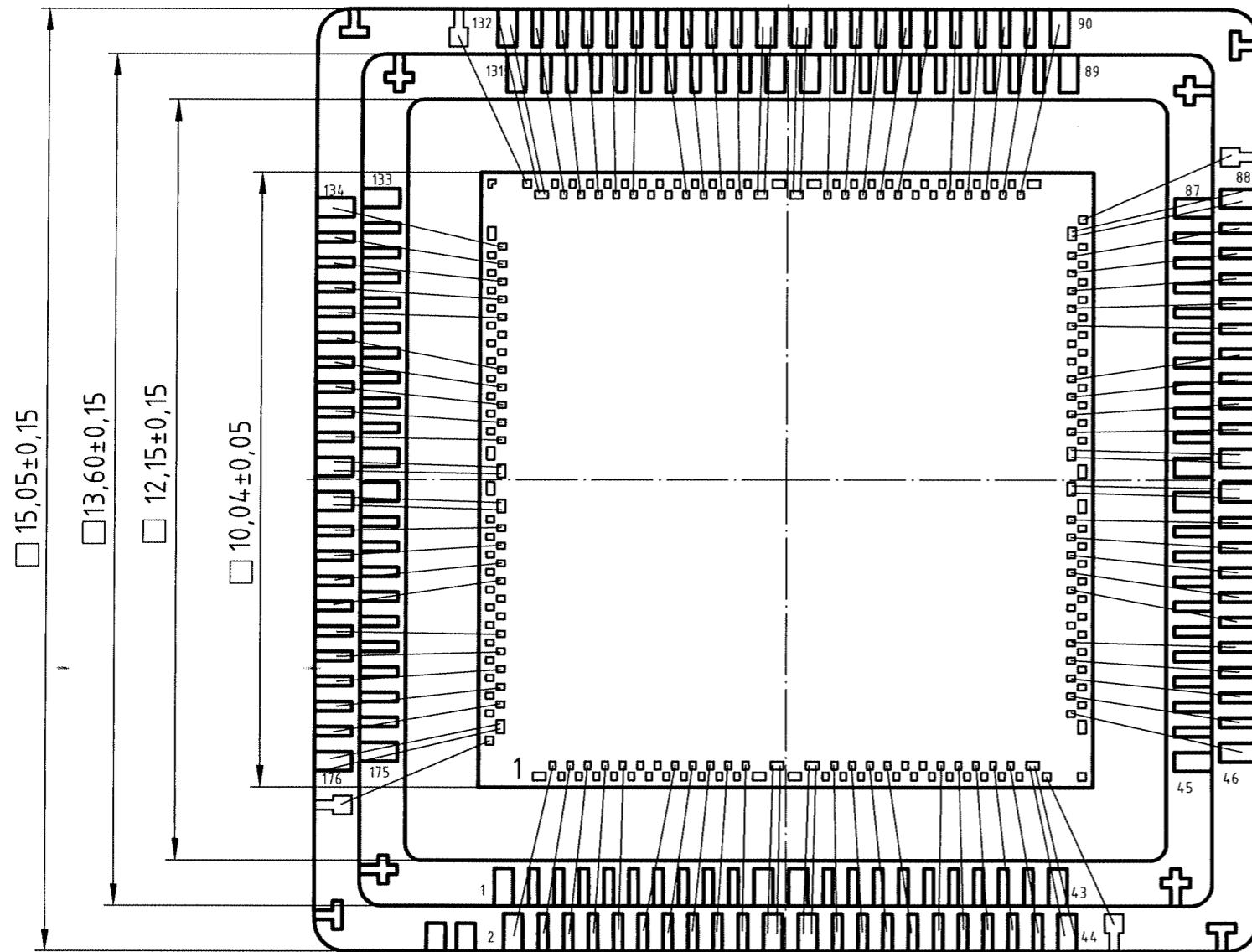
Лист
5

Е (10:1) (4)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны
 Разварка на внешние площадки колодца

Е (10:1) (4)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны
 Разварка на внутренние площадки колодца



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
1549	Лок. Сед. О.А.			

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Сед	Сед
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата	